

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成23年1月20日(2011.1.20)

【公開番号】特開2009-227477(P2009-227477A)

【公開日】平成21年10月8日(2009.10.8)

【年通号数】公開・登録公報2009-040

【出願番号】特願2008-71353(P2008-71353)

【国際特許分類】

C 04 B 35/46 (2006.01)

H 01 C 7/02 (2006.01)

【F I】

C 04 B 35/46 N

H 01 C 7/02

【手続補正書】

【提出日】平成22年11月29日(2010.11.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

Baの一部をBi-Naで置換した半導体磁器組成物の製造方法であって、
電極を形成していない前記半導体磁器組成物を酸素を含む雰囲気中で600以下で熱
 处理する工程を含む半導体磁器組成物の製造方法。

【請求項2】

Baの一部をBi-Naで置換した半導体磁器組成物の製造方法であって、
電極を形成していない前記半導体磁器組成物を大気中で600以下で熱処理する工程
 を含む半導体磁器組成物の製造方法。

【請求項3】

BaTiO₃のBaの一部をBi-Naで置換した半導体磁器組成物の製造方法であつ
 て、

(BaQ)TiO₃仮焼粉(Qは半導体化元素)を用意する工程、

(BiNa)TiO₃仮焼粉を用意する工程、

前記(BaQ)TiO₃仮焼粉及び前記(BiNa)TiO₃仮焼粉を混合する工程、
 混合した仮焼粉を成形し焼結する工程、

得られた焼結体を酸素を含む雰囲気中あるいは大気中で600以下で熱処理する工程
 を含む半導体磁器組成物の製造方法。

【請求項4】

Baの一部をBi-Naで置換した半導体磁器組成物の製造方法であって、
 前記半導体磁器組成物に電極を形成する工程と、
 前記半導体磁器組成物を大気中600以下で熱処理する工程を含む電極付き半導体磁
 器組成物の製造方法。

【請求項5】

請求項1～3の何れか1項に記載の製造方法で得られた半導体磁器組成物に電極を形成
 した電極付き半導体磁器組成物からなる発熱体を有するヒータ。

【請求項6】

請求項4に記載の製造方法で得られた電極付き半導体磁器組成物からなる発熱体を有す

るヒータ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

上記知見に基づき、本発明はBaの一部をBi-Naで置換した電極を形成していない半導体磁器組成物を600以下で熱処理することでジャンプ特性を向上させるものである。熱処理は大気中でもよいが、酸素を含む雰囲気中が好ましく、より速効的には酸素雰囲気中の熱処理が好ましい。